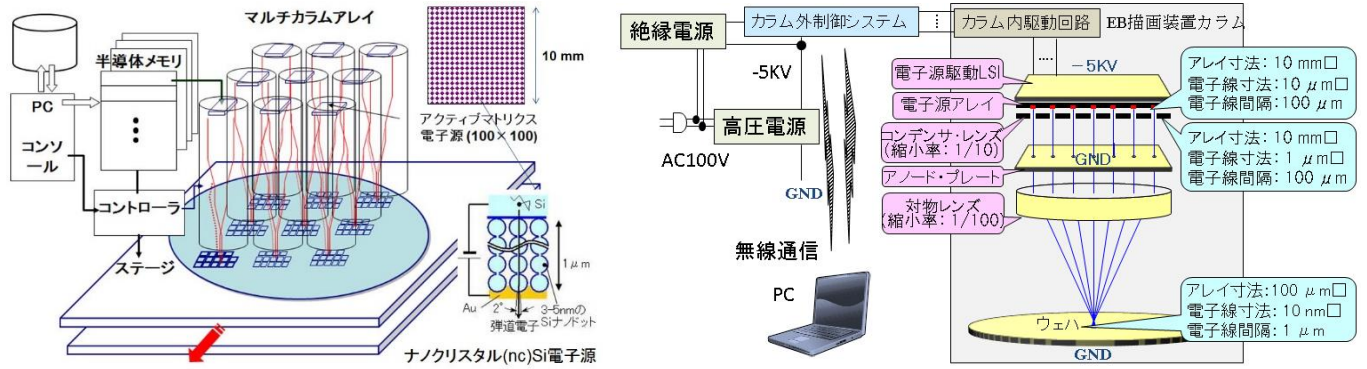
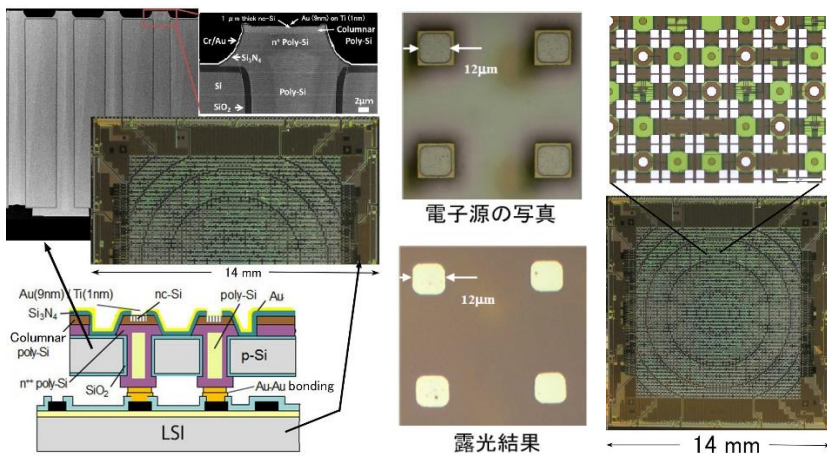


超並列電子ビーム描画装置の開発

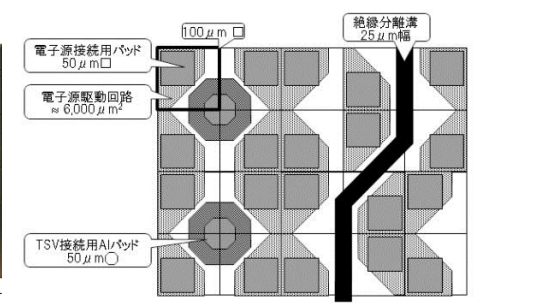


アクティブマトリクス電子源アレイによる電子ビーム描画装置

単一カラムの構成 (試作システムは横型)

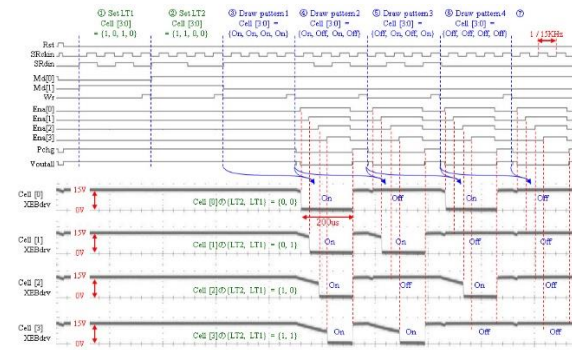
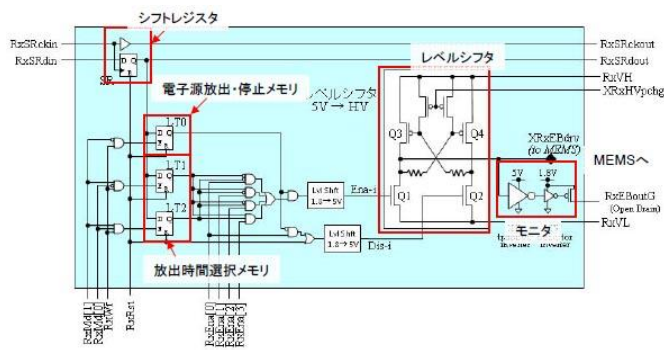


アクティブマトリクス電子源アレイのチップや試作システム、および出版した本「超並列電子ビーム描画装置の開発」は隣室(近代技術史博物館)に設置

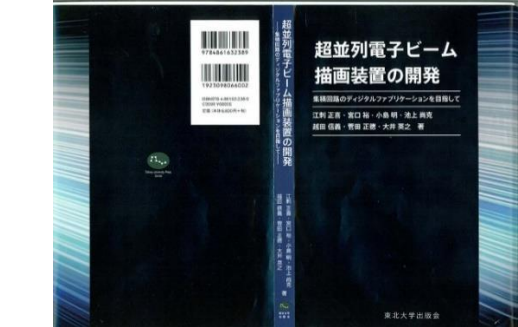
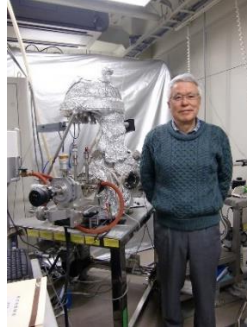


LSIと貫通配線で接続したナノ結晶(nc)Si 電子源

駆動用 LSI (100×100 セル)



M.Esashi, A.Kojima, N.Ikegami, H.Miyaguchi and N.Koshida : Development of Massively Parallel Electron Beam Direct Write Lithography Using Active-matrix Nanocrystalline-silicon Electron Emitter Arrays, *Microsystems & Nanoengineering* (2015) 1, 15029(1-8)



(左から 宮口裕、江刺正喜、小島明、池上尚克、大井英之、菅田正徳) (越田信義) (東北大学出版会 2018)